

2SD1464

シリコン NPN エピタキシャル形

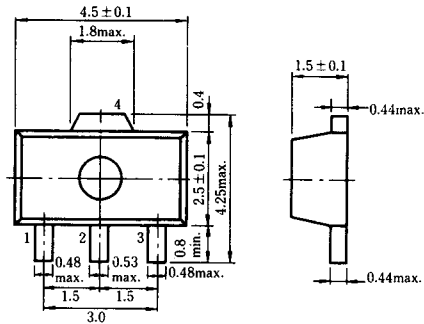
低周波電力増幅用

2SB1046とコンプリメンタリペア

SILICON NPN EPITAXIAL

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SB1046



(UPAK)

1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
 3. エミッタ: Emitter
 4. コレクタ: Collector
- (Dimensions in mm)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SD1464	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	180	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	160	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}^*$	100	mA
許容コレクタ損失	P_C^{**}	1	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

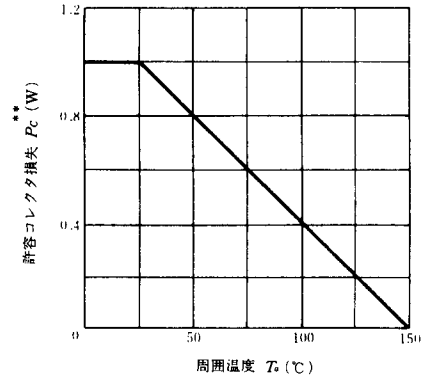
*パルス幅10ms \leq , デューティサイクル \leq 20%

**アルミナセラミック基板(12.5 \times 20 \times 0.7mm)使用時の許容値。

*PW \leq 10ms, Duty cycle \leq 20%

**This value is allowed when using the alumina ceramics board (12.5 \times 20 \times 0.7mm).

許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	180	-	-	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	160	-	-	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5	-	-	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=160\text{V}, I_E=0$	-	-	10	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	60	-	320	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{mA}$	30	-	-	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=30\text{mA}, I_B=3\text{mA}$	-	-	2	V
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	-	-	1.5	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}$	-	140	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	-	3.5	-	pF

*2SD1464は h_{FE1} の値により下記のように2区分し、現品に表示してあります。

*The 2SD1464 is grouped by h_{FE1} as follows.

Mark	HA	HB
h_{FE1}	60 ~ 120	100 ~ 200